

会 告

第 52 回 真空に関する連合講演会

主 催： 日本真空協会

協 賛： 映像情報メディア学会，応用物理学会，化学工学会，原子衝突研究協会，触媒学会，低温工学・超電導学会，電気学会，電子情報通信学会，日本化学会，日本加速器学会，日本機械学会，日本金属学会，日本顕微鏡学会，日本原子力学会，日本材料学会，日本質量分析学会，日本真空工業会，日本チタン協会，日本鉄鋼協会，日本半導体製造装置協会，日本表面科学会，日本物理学会，日本分析化学会，日本放射光学会，表面技術協会，腐食防食協会，プラズマ・核融合学会

期 日： 平成 23 年 11 月 16 日（水）9:30-18:00

平成 23 年 11 月 17 日（木）9:00-17:45 懇親会 18:00-19:30

平成 23 年 11 月 18 日（金）9:00-16:00

会 場： 学習院創立百周年記念会館 3, 4 F（東京都豊島区目白 1-5-1 目白キャンパス）

学習院アクセスマップウェブページ <http://www.gakushuin.ac.jp/map.html>

A 会場（口頭発表）3F 第 1, 第 2 会議室

B 会場（口頭発表）4F 第 4 会議室

C 会場（ポスターセッション，企業展示）小講堂

懇親会場 学習院輔仁会館 2 階さくらラウンジ

参加費： 日本真空協会学生会員 2,000 円

日本真空協会個人会員及び法人会員に属する個人ならびに協賛学協会の会員 4,000 円

非会員 5,000 円

予稿集代金 2,500 円

懇親会 3,000 円

クレジットカードによる事前登録が可能です。連合講演会のウェブページ (<http://www.vacuum-jp.org/CONFV/asvsj2011/index.html>) をご参照ください。

入会のご案内： 参加される方は 9 月末までに入会申込みを行って下さい。日本真空協会学生会員の年会費は 3,500 円ですが，機関誌の配布を希望しない場合は 2,000 円になります。協会のウェブページ (<http://www.vacuum-jp.org/>) の入会方法および入会申込書を参考にしてください。

併設展示会および展示企業プレゼンテーション：本年度もポスターセッション会場（C 会場）において，新製品の紹介と産学の架け橋をすべく，企業展示会（11 月 16 日および 11 月 17 日）を開催いたしますので是非お立ち寄り下さい。期間中には展示企業プレゼンテーション（11 月 16 日 12:45-13:45, 11 月 17 日 12:00-13:00 予定。参加者にはランチ提供（数量限定））を開催します。展示会場のみへの入場は無料です。企業詳細は上記協会ウェブページでお知らせします。

企業展示出展： 25 社程度出展予定。

プロシーディングス: 今回の連合講演会のプロシーディングスは、会誌「Journal of the Vacuum Society of Japan」
として発行する予定です。プロシーディングス原稿の締め切りは平成 23 年 11 月 11 日（金）です。現在運用中
の JSTAGE2 は 9 月末で運用が終わります。投稿には、新システム（運用開始は 9 月末からの運用開始予定）に投
稿していただくようお願いいたします。詳細については、連合講演会のウェブページ上でご案内いたします。尚、
平成 23 年 7 月の投稿規程改訂により、受賞講演、特別講演、シンポジウム講演以外の一般投稿については投稿料
が必要となります。投稿規程 (<http://www.vacuum-jp.org/EDT/Tokokite.pdf>) をご参照ください。

	11月16日					11月17日					11月18日				
	A会場		B会場		C会場	A会場		B会場		C会場	A会場		B会場		
9:00-10:00															
10:00-11:00	開会式典	開会挨拶				表面工学・応用表面科学II・ナノ構造II 前半座長：中村健 後半座長：大岩烈	17Aa-1			17Ba-1	展示会	真空科学・工学III・表面科学I 前半座長：荒川一郎 後半座長：福谷克之	薄膜II		18Ba-1
		受賞記念講演1			17Aa-2				17Ba-2	18Ba-2					
		受賞記念講演2			17Aa-3				17Ba-3	18Ba-3					
11:00-12:00															
	開会式典	受賞記念講演3				電子材料・プロセスII・真空科学・工学II 前半座長：松田七美男 後半座長：鷹野一朗	17Aa-4			17Ba-4	展示会	18Aa-1	薄膜II		18Ba-1
		受賞記念講演2			17Aa-5				17Ba-5	18Aa-2		18Ba-2			
受賞記念講演1				17Aa-6			17Ba-6	18Aa-3	18Ba-3						
12:00-13:00															
	開会式典	受賞記念講演3				表面工学・応用表面科学II・ナノ構造II 前半座長：中村健 後半座長：大岩烈	17Aa-7			17Ba-7	展示会	18Aa-4	薄膜II		18Ba-4
		受賞記念講演2			17Aa-8				17Ba-8	18Aa-5		18Ba-5			
受賞記念講演1				17Aa-9			17Ba-9	18Aa-6	18Ba-6						
13:00-14:00															
	開会式典	受賞記念講演3				電子材料・プロセスII・真空科学・工学II 前半座長：松田七美男 後半座長：鷹野一朗	17Aa-10			17Ba-10	展示会	18Aa-7	薄膜II		18Ba-7
		受賞記念講演2			17Aa-11				17Ba-11	18Aa-8		18Ba-8			
受賞記念講演1				17Aa-12			17Ba-12	18Aa-9	18Ba-9						
14:00-15:00															
	開会式典	受賞記念講演3				電子材料・プロセスII・真空科学・工学II 前半座長：松田七美男 後半座長：鷹野一朗	17Aa-13			17Ba-13	展示会	18Aa-10	薄膜II		18Ba-10
		受賞記念講演2			17Aa-14				17Ba-14	18Aa-11		18Ba-11			
受賞記念講演1				17Aa-15			17Ba-15	18Aa-12	18Ba-12						
15:00-16:00															
	開会式典	受賞記念講演3				電子材料・プロセスII・真空科学・工学II 前半座長：松田七美男 後半座長：鷹野一朗	17Aa-16			17Ba-16	展示会	18Aa-13	薄膜II		18Ba-13
		受賞記念講演2			17Aa-17				17Ba-17	18Aa-14		18Ba-14			
受賞記念講演1				17Aa-18			17Ba-18	18Aa-15	18Ba-15						
16:00-17:00															
	開会式典	受賞記念講演3				電子材料・プロセスII・真空科学・工学II 前半座長：松田七美男 後半座長：鷹野一朗	17Aa-19			17Ba-19	展示会	18Aa-16	薄膜II		18Ba-16
		受賞記念講演2			17Aa-20				17Ba-20	18Aa-17		18Ba-17			
受賞記念講演1				17Aa-21			17Ba-21	18Aa-18	18Ba-18						
17:00-18:00															
	開会式典	受賞記念講演3				電子材料・プロセスII・真空科学・工学II 前半座長：松田七美男 後半座長：鷹野一朗	17Aa-22			17Ba-22	展示会	18Aa-19	薄膜II		18Ba-19
		受賞記念講演2			17Aa-23				17Ba-23	18Aa-20		18Ba-20			
受賞記念講演1				17Aa-24			17Ba-24	18Aa-21	18Ba-21						
18:00-19:00															
	開会式典	受賞記念講演3				電子材料・プロセスII・真空科学・工学II 前半座長：松田七美男 後半座長：鷹野一朗	17Aa-25			17Ba-25	展示会	18Aa-22	薄膜II		18Ba-22
		受賞記念講演2			17Aa-26				17Ba-26	18Aa-23		18Ba-23			
受賞記念講演1				17Aa-27			17Ba-27	18Aa-24	18Ba-24						
19:00-20:00															
	開会式典	受賞記念講演3				電子材料・プロセスII・真空科学・工学II 前半座長：松田七美男 後半座長：鷹野一朗	17Aa-28			17Ba-28	展示会	18Aa-25	薄膜II		18Ba-25
		受賞記念講演2			17Aa-29				17Ba-29	18Aa-26		18Ba-26			
受賞記念講演1				17Aa-30			17Ba-30	18Aa-27	18Ba-27						
懇親会															

第52回真空に関する連合講演会 受賞記念講演・シンポジウム・特別講演一覧

発表番号	講演題目	講演者	所属	セッション名	期日	時間	会場
受賞記念講演	小型高性能力覚センサを用いたロールツーロールスリット装置用張力計測システム	近藤真也	アサヒ電子研究所	受賞記念講演	11月16日	9:45-10:15	A
受賞記念講演	極高真空測定子 (Bent Belt-Beam Gauge Head) の開発	渡辺文夫	真空実験室	受賞記念講演	11月16日	10:15-10:45	A
受賞記念講演	隔膜真空計を用いた圧力測定のための熱遷移補正	吉田 肇	産総研	受賞記念講演	11月16日	10:45-11:15	A
16Aa-1	TOF-SIMSデータ解析へのケモトリクスの応用	青柳里果	島根大生物資源	応用表面科学I・ナノ構造I	11月16日	11:30-12:00	A
16Aa-2	バイオマイクロマシンの創製と応用	生田幸士	東大情報理工	応用表面科学I・ナノ構造I	11月16日	12:00-12:30	A
16Ap-1	薄膜電子材料の最近の進展: 高性能酸化物半導体と鉄系超電導エビ膜	細野秀雄	東工大応セラ研	電子材料・プロセスI	11月16日	16:15-16:45	A
17Aa-6	物理的蒸着法による薄膜のナノ形態制御	鈴木基史	京大工	表面工学・応用表面科学II・ナノ構造II	11月17日	10:30-11:00	A
17Aa-9	超高分解能電子顕微鏡によるリチウム原子の可視化	大島義文	阪大電顕セ	表面工学・応用表面科学II・ナノ構造II	11月17日	11:30-12:00	A
17Ba-4	重力波検出器と気体分子運動	高橋竜太郎	東大宇宙研	電子材料・プロセスII・真空科学・工学II	11月17日	9:45-10:15	B
17Ap-1	X線磁気ホログラフイメージングによるナノ磁区構造の可視化	鈴木 基寛	高輝度光セ	シンポジウム	11月17日	15:15-15:50	A
17Ap-2	マグネタイトウィスカーからの電界放出電子のスピン偏極度	永井滋一	三重大工	シンポジウム	11月17日	15:50-16:25	A
17Ap-3	半導体スピントロニクス ―材料とデバイス研究	田中雅明	東大工	シンポジウム	11月17日	16:35-17:10	A
17Ap-4	MRAM実用化に向けた歩み	與田博明	東芝研開セ	シンポジウム	11月17日	17:10-17:45	A
18Ba-10	垂直磁気記録媒体用の擬似六方晶薄膜における六方晶原子層積層のコヒーレンシー ― Ru代替材料の発見からCo基強磁性薄膜の結晶磁気異方性の向上まで ―	斎藤 伸	東北大工	薄膜II	11月18日	11:30-12:00	B
18Ap-1	超高輝度・高スピン偏極低エネルギー電子顕微鏡を用いた表面研究	安江常夫	大阪電通大	表面科学II	11月18日	13:00-13:30	A
18Bp-4	コンビナトリアルによるプラズマ科学の構築と有機材料の超微細加工への展開	堀 勝	名大工	プラズマ科学技術	11月18日	14:00-14:30	B

第52回真空に関する連合講演会プログラム

11/16(水)

A会場 午前の部

【開会式・表彰式・受賞記念講演】 9:30-11:15

開会の挨拶・表彰式 9:30-9:45

受賞記念講演 9:45-11:15

真空技術賞	小型高性能力覚センサを用いたロールツーロールスパッタ装置用張力計測システム	1)株式会社アサヒ電子研究所、2)小川創造技術研究所	近藤真也1)、玉置 肇1)、小川倉一2)
真空技術賞	極高真空測定子(Bent Belt-Beam Gauge Head)の開発	真空実験室	渡辺文夫
真空進歩賞	隔膜真空計を用いた圧力測定のための熱遷移補正	産総研	吉田 肇

《休憩》

A会場 午前の部

口頭発表 I【応用表面科学・ナノ構造I】 11:30-12:30 座長 藤田大介(NIMS)

16Aa-1	TOF-SIMSデータ解析へのケモメトリクスの応用	島根大生物資源	青柳里果
16Aa-2	バイオマイクロマシンの創製と応用	東大情報理工	生田幸士

B会場 午前の部

口頭発表 II【真空科学・工学I】 11:30-12:30 座長 大林哲郎(大阪真空)

16Ba-1	シートビーム作成を目的としたキャピラリーからの放出ガスの指向性に関する実験	1)原子力機構	°荻原 徳男1)、引地 祐輔1)、神谷 潤一郎1)
16Ba-2	アルミ鋳物合金のガス放出特性	(株)アルバック	°舛分 倫子、稻吉 さかえ、岡本 正智、柴山 浩司
16Ba-3	チタン材料の溶存水素放出に対する酸化効果	1)山口大院理工、2)UBE科学分析センター、3)三菱プラント工業	竹田 将利1,2)、栗巢 普揮1)°、町田 光誠1)、山本 節夫1)、中川 浜三2)、石澤 克修3)
16Ba-4	St707ストリップ、St172モジュールを用いた非蒸発ゲッター(NEG)アセンブリの製作と性能評価	1)高エネルギー加速器研究機構PF、2)(有)真空実験室	°菊地 貴司1)、間瀬 一彦1)、渡辺 文夫2)
16Ba-5	Pakistan Vacuum Society and its Achievements	1)Quaid-I Azam University	°HAJI MUHAMMAD AKRAM1)

《休憩》

C会場 昼の部

展示企業プレゼンテーション 12:45-13:45

C会場ポスターセッション I 14:00-16:00 (奇数番号コアタイム 14:00-15:00 偶数番号コアタイム 15:00-16:00)

16P-1	気体放出源がある狭い平行平板間から放出される気体分子の衝突回数分布	1)電機大、2)高エネ研	°松田七美男1)、佐藤吉博2)、齊藤芳男2)
16P-2	B-A真空計の感度係数変化に関するシミュレーション	産業技術総合研究所	°杉沼 茂実、平田 正紘
16P-3	膨張法による中真空標準	1)産総研	°秋道 斉1)、小松 栄一1)
16P-4	スピニングロータ真空計のロータ表面状態の感度への影響	1)産総研	°秋道 斉1)、小松 栄一1)
16P-5	標準リークの比較校正のための安定性試験	産総研 計測標準	新井健太、吉田 肇、平田正紘、秋道 斉、小島時彦
16P-6	薄膜シリコン太陽電池材料製造装置用シラン-水素濃度計の開発	1)産総研	°鈴木淳、黒河明、永井武彦、松井卓矢、近藤道雄
16P-7	ビームロス低減のための3GeVシンクロトロン漏洩磁場遮蔽の概要	1)日本原子力研究開発機構	神谷 潤一郎1)、荻原 徳男1)、林 直樹1)、撥知 英明1)、吉本 政弘1)、金正 倫計1)
16P-8	磁気シールド付ターボ分子ポンプの開発	1)原子力機構	°荻原 徳男1)、神谷 潤一郎1)、柳橋 亨1)、引地 祐輔1)、西川 雅章1)
16P-9	キッカー電磁石に組込まれたフェライトのin situでの脱ガス手法の開発	1)日本原子力研究開発機構	°神谷 潤一郎1)、荻原 徳男1)、引地 裕輔1)、柳橋 亨1)、西川 雅章1)、菅沼 和明1)
16P-10V	SUS430製真空容器の放出ガス速度測定	1)東北大理、2)日本原子力研究開発機構	°加藤 新一1)、神谷 潤一郎2)、山本 風海2)、吉本 政弘2)、金正 倫計2)
16P-11	ヘリウム照射後の核融合炉ブランケット用SiC/SiC複合材料の水素保持・脱離特性	1)北大、2)東義大学(韓国)	信太 祐二1)°、山内 有二1)、日野 友明1)、Han-Ki Yoon2)
16P-12V	真空多層断熱材用アルミ蒸着ポリエステルフィルムの気体放出速度の測定	1)帝京大学、2)高エネルギー加速器研究機構、3)榊栃木カネカ、4)榊カネカ	高田聡1)、佐藤博史2)、大森隆夫1)、齋藤芳男2)、鈴木敏一2)、木村誠宏2)、都丸隆行2)、久万剛3)、西田茂雄4)
16P-13V	チタン材料の光刺激ガス脱離	1)山口大院理工、2)KEK	長石 健一1)、栗巢 普揮1)°、堀内 達也1)、山本節夫1)、山本 将博2)
16P-14V	熱間等方加圧処理(HIP処理)を施した無酸素銅電極および焼結銅電極の真空中絶縁破壊特性	1)埼玉大学大学院理工学研究科、2)高エネルギー加速器研究機構	廣岡 悠真1)、山納 康1)、小林 信一1)、齊藤芳男2)
16P-15V	低抵抗アルミナセラミックスにおける真空中治面放電特性	1)埼玉大、2)高エネ研、3)京セラ	福田 英昭1)、山納 康1)、小林 信一1)、道園真一郎2)、齊藤 芳男2)、前田 岳志3)
16P-16V	宇宙機誘電体材料の光電子電流の測定	1)埼玉大、2)宇宙航空研究開発機構、3)東京都市大、4)高エネ研	南條 佑太1)、山納 康1)、仁田 工美2)、三宅弘晃3)、伊藤 健二4)、小林 信一1)
16P-17	軌道暴露により生成された酸化珪素膜	物質・材料研究機構	°土佐 正弘、笠原 章、後藤 真宏
16P-18	Tribological Properties of Nano-structured WC-Co Coatings	1) Politecnico di Torino, 2) NIMS	G. Maizza 1)、A. Tassinari 1)、A. Kasahara 2)、°M. Tosa 2)、T. Noda 2)
16P-19V	有機高分子試料への電子ビーム照射の分子シミュレーション(2)	1)大阪府大工	°荒木 康誠1)、酒井 裕史1)、安田 雅昭1)、川田 博昭1)、平井 義彦1)
16P-20	レーザーデネーション法を用いた超音速混合原子ビームの形成と評価	神戸大院	横田 久美子°、安田 茂、水谷 朗、田川 雅人
16P-21	V(001)表面酸化膜の熱変性過程の光電子分光観察と重水素脱離の同時測定	1)原子力機構	戸出 真由美1)、James R. Harries1)、°寺岡 有毅1)、吉越 章隆1)
16P-22	アルミナ-金属界面の結合を介する原子の種類を予測する一般式	1)物質・材料研究機構	°吉武 道子1)、柳生 進二郎1)、知京 豊裕1)
16P-23	ショットキーバリア高さ制御のための元素添加によるアルミナ-金属界面結合変化の定量的予測式	1)物質・材料研究機構	°吉武 道子1)、ネムシャク スラボミール1)、柳生進二郎1)、知京 豊裕1)
16P-24	SiC微粒子からの熱電子放射	1)東洋大理工 2)三重大工	吉本 智巳1)、岩田 達夫2)

16P-25	高分解能TOF-SIMSを用いた微粒子粒別起源解析法の開発	1)東工大資源研、2)工学院大院工	°間山 憲仁1、2)、後藤 栄太2)、三浦 祐哉2)、大石 乾詞2)、坂本 哲夫2)、藤井 正明1)
16P-26	高温Si(113)表面における水素吸着構造の評価	1)横国大工、2)防衛大	°安部 壮祐1)、大野 真也1)、鈴木 隆則2)、田中 正俊1)
16P-27V	STM及びRDSIによるSi(001)-c(4x2)表面上におけるCO吸着脱離の研究	1)横国大工、2)防衛大	°百瀬 辰哉1)、大野 真也1)、北嶋 武2)、鈴木 隆則2)、田中 正俊1)
16P-28	石英基板上の単層カーボンナノチューブから発生する第二高調波の特性	1)横国大工、2)防大応物	°大河原 悟1)、宮森 麻理子1)、田中 正俊1)、大野 真也1)、島津 佳弘1)、鈴木 隆則2)
16P-29V	グラファイト上の欠陥及び金蒸着表面の構造と電子状態	1)横国大院・工	井上 晶博1) 首藤 健一1)
16P-30V	紫外光電子分光装置用電源製作とH/Pd(111)電子状態測定への応用	1)筑波大数理、2)筑波大研究基盤総合センター	°栗田 圭輔1)、所畑 成明1)、大島 弘行2)、関場 大一郎2)
16P-31V	アモルファス氷表面におけるオルト水素・パラ水素分子の物理吸着状態密度	東大生研	°杉本 敏樹、福谷 克之
16P-32	LEEMによるAu/Ni(111)の二重表面構造成長過程の顕微観察	1)大阪電通大エレクトロニクス研、2)大阪府立大	°橋本 道廣1)、梅澤 憲司2)、安江 常夫1)、越川 孝範1)
16P-33V	レーザー誘起によるXe高速熱脱離過程に関する研究	東大生研	池田 暁彦、松本 益明、小倉 正平、福谷 克之、岡野 達雄
16P-34	超低速イオンビームを用いた2次イオン質量分析装置の開発	1)阪大リノベーション、2)阪大理工	°橋之口 道宏1)、岡田 美智雄1、2)
16P-35V	高速陽子の散乱パターン観察によるイオン結晶表面のステップ密度の導出	大阪教育大	°深澤 優子、池本 将健、柴田 卓、鈴木 康文
16P-36	金属表面上コロネン分子層に関する微視的研究	1)筑波大数物	°矢野 雅大1)、松野 寛1)、山田 洋一1)、佐々木 正洋1)
16P-37	ベンタセン-C60分子相接合界面に関するSTMを用いた検討	1)筑波大数物	°中山 拓人1)、山田 洋一1)、佐々木 正洋1)
16P-38	マイクロ波プラズマCVD法によるカーボンナノウォールの生成	1)東洋大学大学院	°塩原 正記1)
16P-39	マイクロ波プラズマCVD法による鉄ナノ粒子からのカーボンナノチューブ生成	1)東洋大 理工学部	°神倉 翔一1)
16P-40V	ナノカーボン材料を対象とした電子ビーム誘起構造変化の分子シミュレーション(3)	1)大阪府大工	°地原 由倫1)、安田 雅昭1)、川田 博昭1)、平井 義彦1)
16P-41	熱酸化シリコン薄膜へのゲルマニウム負イオン斜め注入による極表層での発光サイト形成	1)京大院工、2)シャープ	°辻 博司1)、洗 暢俊2)、木下 翔平1)、宮川 豪1)、原田 真臣2)、小滝 浩2)、後藤 康仁1)
16P-42V	PTFE表面形態のイオンビーム照射角度依存性	1)工学院大工	°松浦 美紀1)、鷹野 一朗1)

A会場 午後の部

口頭発表III【電子材料・プロセスI】 16:15-17:45 座長 杉山直治(東芝)

16Ap-1	薄膜電子材料の最近の進展:高性能酸化半導体と鉄系超電導エビ膜	東工大応セラ研	細野秀雄
16Ap-2	第一原理計算を用いたペロブスカイト型酸化物の自発分極に関する理論的研究	1)阪大院工	岡 耕平 ¹ 、中西 寛 ¹ 、笠井 秀明 ¹
16Ap-3	DLC膜成長の光電子制御プラズマ放電条件依存	1)東北大多元研、2)東北大通研、3)CREST-JST	°楊 猛1)、小川 修一1)、鷹林 将2,3)、尾辻 泰一2,3)、高桑 雄二1)
16Ap-4	半導体デバイス解析用局所プラズマ加工装置の開発(4)プラズマ加工中の温度精密計測	1)(株)三友製作所、2)(独)産総研	°岩瀬 千克1)、白山 裕也1)、横須賀 俊太郎1)、櫻村 健太1)、林 明宏1)、新堀 俊一郎1)、高橋 賢2)、堀江 智之2)、徳本 洋志2)、内藤 泰久2)、清水 哲夫2)
16Ap-5	半導体デバイス解析用局所プラズマ加工装置の開発(3)四重極質量分析による加工モニタリング	1)産総研、2)(株)三友製作所	°高橋 賢1)、堀江 智之1)、白山 裕也2)、横須賀 俊太郎2)、櫻村 健太2)、林 明宏2)、岩瀬 千克2)、新堀 俊一郎2)、徳本 洋志1)、内藤 泰久1)、清水 哲夫1)

B会場 午後の部

口頭発表IV【薄膜I】 16:15-17:45 座長 板倉明子(NIMS)

16Bp-1	鉄薄膜における表面磁気キャンティング	1)東大生研、2)高工研、3)JASRI	°河内泰三1)、福谷克之1)、松本益明1)、小田克郎1)、張 小威2)、岸本俊二2)、依田芳卓3)、岡野達雄1)
16Bp-2	c-BN膜の高温応用の可能性	1)神港精機機、2)兵庫県立工業技術センター3)滋賀県東北部工業技術センター	野間 正男1) 山下 満2) 所 敏夫3)
16Bp-3	反応性蒸着による細管内壁へのTiNコーティング	1)東海大学	°林田 史彦1)、篠原 義明1)、玉森 亮佑1)、松村 義人1)
16Bp-4	アルミナ膜をプロトン伝導体に応用した燃料電池の特性評価	1)大阪工大 工	°長井 未紗子1)
16Bp-5	LED透明電極のためのITO成膜装置の開発	1)株式会社オプトラン	°臼杵 亨1)、張 大鎬1)、范 濱1)
16Bp-6	高精度In situ光学膜厚モニタシステムの研究	株式会社オプトラン	°長家 武彦1)、範 濱2)

11/17(木)

A会場 午前の部

口頭発表【表面工学・応用表面科学 II・ナノ構造 II】 9:00-12:00 座長 中村健(AIST)/大岩烈(オミクロンナノテクノロジー)

17Aa-1	高温における耐食性を向上させたアノード酸化処理の開発	1)(株)アルバック 筑波超材研	°石樽 文昭1)、福吉 さかえ1)
17Aa-2	アルミ・酸素同時供給によるエビ酸化膜成長におけるNi基板中のSiコンタミの影響	1)物質・材料研究機構、2)シンクロトロン トリエステ、3)カレル大学	°吉武 道子1)、ネムシャク スラボミール1)、スカラ トーマス2)、ゾット ナタリア3)、マトリン ウラジミール3)、プリンス ケビン2)
17Aa-3	紫外線励起酸素を用いた滅菌システムにおける酸素注入条件の検討	1)岩崎電気(株)、2)産総研、3)東海大学	吉野 潔1)、松本 裕之1)、岩崎 達行1)、木下 忍1)、野田 和俊2)、岩森 暁3)
17Aa-4	有機薄膜付水晶微小天秤(QCM)を用いた励起酸素の表面作用量モニター検討	1)岩崎電気、2)産総研、3)東海大	松本 裕之1)、°吉野 潔1)、岩崎 達行1)、木下 忍1)、野田 和俊2)、岩森 暁3)

17Aa-5	光電子制御イオン源によるCu蒸着膜の表面処理	東北大多元研	°大友 悠大、小川 修一、阿加 賽見、高桑 雄二
		《休憩》	
17Aa-6	物理的蒸着法による薄膜のナノ形態制御	京大工	鈴木基史
17Aa-7	電極材料におけるチオール・カルボン酸の修飾特性	1) 物材機構	°柳生 進二郎1)、吉武 道子1)、知京 豊裕1)
17Aa-8	Liイオン二次電池のガス放出挙動と性能向上に関する研究	1) 北大工	°高丸翔太1)、日野友明1)、山内有二1)
17Aa-9	超高分解能電子顕微鏡によるリチウム原子の可視化	阪大電顕セ	大島義文

B会場 午前の部

口頭発表【電子材料・プロセスII・真空科学・工学II】 9:00-12:00 座長 松田七美男(東京電機大)/鷹野一朗(工学院大)

17Ba-1	標準コンダクタンスエレメントとコンダクタンス変調法の組み合わせによる、ターボ分子ポンプの排気速度と電離真空計の感度のその場測定法	1) 産総研	吉田 肇1)、秋道 齊1)、小畠 時彦1)
17Ba-2	排気曲線による真空容器内壁の吸着状態密度の導出	1) 東大生研	°武安 光太郎1)、杉本 敏樹1)、福谷 克之1)
17Ba-3	モンテカルロ法によるペローズ管の通過確率	1) 函館高専、2) 日本原子力研究開発機構	°正木 健太郎1)、祐延 悟1)、荻原 徳男2)
17Ba-4	重力波検出器と気体分子運動	東大宇宙研	高橋竜太郎
		《休憩》	
17Ba-5	熱陰極電離真空計の安定性 -トレーサビリティの視点から-	1) 株式会社アルバック	°高橋 直樹1)
17Ba-6	実用的極高真空計(計算機シミュレーション)	1) 神戸大学	°金持 徹1)、櫻井 誠1)
17Ba-7	電子ビーム多価イオン源の特性	1) 神大理、2) 電通大、3) 核融合研	°櫻井 誠1)、大谷 俊介2)、坂上裕之3)
17Ba-8	シリコン系電界放出電子源を用いた大電流・低エネルギーイオンビームの空間電荷中和	1) 京大・院工、2) 中部大・工、3) 日新イオン機器	°後藤 康仁1)、田口 周平1)、池田 啓太1)、辻 博司1)、石川 順三2)、酒井 滋樹3)
17Ba-9	High Current Density from Multi Emitter Array of CNTs	1) GUAS,2) KEK	Vijay Chouhan1), Tsuneyuki Noguchi 2), Shigeki Kato 1,2)
17Ba-10	フィールドエミッタアレイを用いた周波数混合器の試作	1) 京大・院工	°安友 佳樹1)、大上 航1)、後藤 康仁1)、辻 博司1)

C会場 昼の部

展示企業プレゼンテーション 12:00-13:00

C会場ポスターセッション I 13:00-15:00 (奇数番コアタイム 13:00-14:00 偶数番コアタイム 14:00-15:00)

17P-1	溝型構造を有するシリコンへの炭素負イオン注入処理による溝構造内壁の細胞接着性付与	京大院工	°辻 博司、佐藤 弘子、中塚ピヤヌット、大岡正考、後藤康仁
17P-2	チャネリング効果を用いたSi(001)への高エネルギーBイオン注入	1) 福井高専、2) 立命大SRセンター	°米田 知晃1)、山本 安一2)
17P-3	ルチル型二酸化チタンへの白金負イオン注入による光触媒特性の向上	1) 京大院工、2) シャープ	宮川 豪1)、°辻 博司1)、洗 暢俊2)、木下 翔平1)、原田 真臣2)、小滝 浩2)、後藤 康仁1)
17P-4	超高濃度オゾンガスのエチレン分解反応に関する分光学的検討	1) 明電舎、2) 産総研	°三浦 敏徳1)、亀田 直人1)、花倉 満1)、野中 秀彦2)、中村 健2)
17P-5	シリコン系電界放出電子源を用いた超低速電子ビーム形成技術の開発	1) 京大・院工、2) 中部大・工、3) 日新イオン機器	°後藤 康仁1)、田口 周平1)、北川 貴之1)、石川 順三2)、池田 啓太1)、辻 博司1)、酒井 滋樹3)
17P-6	プラズマガス基板相互作用とダイヤモンド初期成長過程	長崎総合科学大 工	篠崎 翔一※、大岩 忠利、奥野 公夫
17P-7	DLC-下地界面原子構造のFIM観察	1) 長崎総合科学大、2) 東洋大工	※江頭 威夫貴1)、奥野 公夫1)、吉本 智巳2)
17P-8	イオンビーム照射により界面制御されたDLC薄膜の作製	1) 工学院大工	°西 勇人1)、鷹野 一朗1)
17P-9V	He+イオンビームアシスト法により作製されたフッ素添加DLC薄膜の摩擦・摩耗特性	1) 工学院大工	°黒須 雅浩1)、鷹野 一朗1)
17P-10V	N+イオン照射したTiO2薄膜の光機能特性	1) 工学院大学	°シュクル ハイデル1)、佐藤 光史1)、鷹野 一朗1)
17P-11	酸化チタン薄膜の光機能性に対する磁場印加の影響	1) 工学院大学	°豊田 亜貴子1)、鷹野 一朗1)
17P-12V	積層型N-TiO2/TiO2薄膜の光機能特性	1) 工学院大学	°荒原 茂幸1)、鷹野 一朗1)
17P-13	反応性スパッタリング法による酸化銅薄膜の電気的特性に対するArガス流量の影響	1) 工学院大学	シュクルアヌマル1)、°ハイデルアリ1)、鷹野一朗1)
17P-14	RAS(Radical Assisted Sputtering)法により作製したTa2O5固体電解質薄膜の物性評価とイオン伝導度制御技術に関する研究	1) 都城工業高等専門学校 物質工学科、2) 株式会社シンクロン、3) 株式会社ホンダロック	°谷川 優美1)、塩野 一朗2)、清 文博3)、河野 慶彦3)、福留 政治3)、野口 大輔1)
17P-15	反応性スパッタ法によるAl-ON薄膜の作製と諸特性	1) 岡野製作所、2) 小川創造技術研究所、3) 大阪市立大学	°田尻 修一1)、青園 隆司1)、小川 倉一2)、美馬 宏司3)
17P-16	AIN/Al/AINナノ積層膜の作製と電気・光学的特性について	1) 小川創造技術研究所、2) 株式会社清水製作所	小川 倉一1)、°近藤 匡俊1)、清水 正美2)、安田 政智2)、李 普鉉2)
17P-17V	酸化亜鉛系材料を用いた熱線反射膜の作製	1) 大阪産大工	°大橋 俊介1)、青木 孝憲1)、鈴木 晶雄1)
17P-19V	高温成膜による抵抗率の悪化を抑制した酸化亜鉛系透明導電膜	1) 大阪産大工	°中 崇人1)、青木 孝憲1)、鈴木 晶雄1)
17P-20V	フルスペクトル対応の太陽電池用TZO透明導電膜	1) 大阪産大工	°松延 光章1)、青木 孝憲1)、鈴木 晶雄1)
17P-21V	有機基板上に成膜したTZO透明導電膜に関する研究	大阪産大工	近藤 剛成、鈴木 晶雄、青木 孝憲
17P-22V	酸化シリコンを添加した酸化亜鉛系透明導電膜へのレーザーアニール	1) 大阪産大工	伊島 匡亮1)、°伊島 匡亮1)、青木 孝憲1)、鈴木 晶雄1)

17P-23	New-MHVスパッタ装置による高品質ITO薄膜の作製-II	1)株式会社清水製作所、2)小川創造技術研究所	清水 正美1)、安田 政智1)、李 普鉉1)、小川 倉一2)、近藤 匡俊2)
17P-24V	可搬型サーマルサイクラーの放熱と熱応答性	1)神奈川大工	°奥脇 容子1)、山口 栄雄2)
17P-25	有機金属相成長法を用いたInSbTe薄膜の作製と評価	1)神奈川大工	°石井 辰弥1)、山口 栄雄1)
17P-26	遷移金属酸化物ReRAMのリセット機構	1)鳥取大学、2)鳥取大学電子ディスプレイ研究センター(TEDEC)	°吉原 幹貴1)、木下 健太郎1)2)、田中 隼人1)、岸田 悟1)2)
17P-27V	遷移金属酸化物ReRAMにおけるフィラメント分布と動作特性の関係	1)鳥取大工、2)TEDREC	田中 隼人1)、°木下 健太郎1)2)、吉原 幹貴1)、岸田 悟1)2)
17P-28V	BaTiO ₃ 薄膜の自立化に伴う特性変化	1)鳥取県産業技術センター、2)鳥取大学工学部、3)鳥取大学工学部附属電子ディスプレイ研究センター	吉田 大一郎1)2)、°木下 健太郎2)3)、三浦 寛基2)、高橋 智一1)、岸田 悟2)3)
17P-29V	RFマグネトロンスパッタ法によるBaTiO ₃ の低温成膜	1)鳥取大学、2)鳥取大学工学部電子ディスプレイ研究センター、3)鳥取県産業技術センター	三浦 寛基1)°、木下 健太郎1)2)、吉田 大一郎1)3)、岸田 悟1)2)
17P-30V	パルスレーザー堆積法によるエピタキシャル(Na、K)NbO ₃ 薄膜の作製とその物性	1)東理大材料、2)産総研	°櫻井 健人1)、菊地 直人2)、西尾 圭史1)、王 瑞平2)、外岡 和彦2)、阪東 寛2)、高島 浩2)
17P-31V	パルスレーザー堆積法によるエピタキシャルBa(Ti,Zr)O ₃ -(Ba,Ca)TiO ₃ 薄膜の作製と評価	1)東理大材料、2)産総研	°高部 遼1)、菊地 直人2)、西尾 圭史1)、王 瑞平2)、外岡 和彦2)、阪東 寛2)、高島 浩2)
17P-32	高真空スパッタ法で作製されたRu/バリア層付きトレンチへの超臨界CO ₂ 法によるCu埋め込み	1)東京理科大学 工学研究科 電気工学専攻、2)東京理科大学 工学部 工業化学科	伊藤 勝利1)、大野 泰典1)、°沼川 智則1)、大竹 勝人2)、斉藤 茂1)
17P-33	Coバリア層を用いた高真空スパッタ法によるトレンチへのCu埋め込み	1)東理大工	°伊藤 勝利1)、新井 清孝1)、斉藤 茂1)
17P-34	反応性スパッタリング法によるPtO _x 薄膜の光触媒特性	1)明大理工、2)明大電子物性研	°田中 貴士1)、湯浅 朗道1)、西村 孔三1)、後藤 辰弥1)、三浦 登1)、松本 節子1)、松本 皓永1)
17P-35	反応性スパッタリング法によるKTN薄膜の作製と評価	1)明治大学2)電子物性研	°後藤 辰弥1)、西村 孔三1)、湯浅朗道1)、三浦 登1)、松本節子1)、松本皓永1)
17P-36	RAS(Radical Assisted Sputtering)法により作製したWO ₃ 還元発色薄膜の物性評価とEC特性制御技術に関する研究	1)都城工業高等専門学校 物質工学科、2)株式会社 シンクロン、3)株式会社 ホンダ ロック	°池田 将人1)、塩野 一朗2)、清 文博3)、河野 慶彦3)、福留 政治、野口 大輔1)
17P-37	グラニュー型垂直磁気記録媒体における成長初期部への高ガス圧成膜層挿入による磁気的交換結合の抑制	1)一関高専、2)東北大	°佐々木 晋五1)、斉藤 伸2)、高橋 研2)
17P-38V	ポリエチレンナフタレート有機膜上のCo強磁性薄膜における表面粗さと磁気特性	1)北大電子研、2)JSTさきがけ	海住 英生1、2)、°阿部 太郎1)、近藤 憲治1)、石橋 晃1)
17P-39	c面サファイア基板上バナジウム酸化膜におけるマグネリ相を含む共存モデル	1)東海大工	°鈴木 康史1)、沖村 邦雄1)
17P-40V	高周波スパッタリングにより形成した有機薄膜のVOC(アセトン)の吸着特性	1)東海大・工、2)AIST	°大西 康貴1)、池田 佑旭1)、岩森 暁1)、野田 和俊2)
17P-41	マイクロハクマク圧力センサによる真空装置内圧力分布計測の試み	1)岡野製作所、2)小川創造技術研究所、3)大阪市立大学	°田尻 修一1)、青園 隆司1)、小川 倉一2)、美馬 宏司3)
17P-42V	金ナノ粒子からの光音響放出の干渉による制御	1)京大院・工	°名村 今日子1)、鈴木 基史1)、中嶋 薫1)、木村 健二1)

《休憩》

A会場 午後の部

シンポジウム「スピニに関連する最近の展開—基礎科学から応用展開まで—」 15:10-17:50 座長:高橋研(東北大)

17Ap-1	X線磁気ホログラフィーイメージングによるナノ磁区構造の可視化	高輝度光セ	鈴木 基寛
17Ap-2	マグネタイトウィスカーからの電界放出電子のスピニ偏極度	三重大工	永井滋一
17Ap-3	半導体スピントロニクス—材料とデバイス研究	東大工	田中雅明
17Ap-4	MRAM実用化に向けた歩み	東芝研開セ	與田博明

11/18(金)

A会場 午前部

口頭発表Ⅶ【真空科学・工学Ⅲ・表面科学I】 9:00-12:00 座長:荒川一朗(学習院大)/福谷克之(東大生研)

18Aa-1	標準コンダクタンスエレメントで校正した四重極質量分析計を用いた昇温脱離測定	1)アルバック、2)産総研	°稲吉 さかえ1)、茂木 かおり1)、吉田 肇2)、秋道 齊2)、小島 時彦2)
18Aa-2	ルチル型TiO ₂ (110)面の表面欠陥による電子準位と水素吸着による変化	1)東大生研	°深田 啓介1)、武安 光太郎1)、松本 益明1)、村田 好正1)、福谷 克之1)
18Aa-3	Pd(110)への水素侵入機構	1)東大生研	°大野 哲1)、ヴィルデ マーカス1)、福谷 克之1)
18Aa-4	Pd ₃₀ Au ₇₀ (110)の水素吸放出におけるCO吸着効果	1)東大生研、2)阪大リノベーション	°小倉 正平1)、岡田 美智雄2)、福谷 克之1)
18Aa-5	Ag(111)表面上の水素分子のオルソ・パラ転換におけるファン・デル・ワールス力の影響	1)阪大院工	°國貞 雄治1)、中西 寛1)、Wilson Agerico Dino1)、笠井 秀明1)

《休憩》

18Aa-7	Si高指数面における水素終端構造: 純水リンスによるエッチングの影響	1)横国院工、2)産総研	°兼村 瑠璃1)、西澤 正泰2)、大野 真也1)、田中正俊1)、安田 哲二2)
18Aa-8	Si(001)表面のTi吸着構造における正孔擬ポテンシャルを用いた化学シフト解析	1)横国院工、2)阪大院工	°牛山 翔太1)、首藤 健一1)、森川 良忠2)
18Aa-9	高分解能コインシデンス分光器の開発及び表面水素化Si(111)の局所電子状態の研究	1)横国大院工、2)群馬大教、3)愛媛大院理工、4)KEK 物構研、5)総研大	°新江 定憲1)、小柏 洋輔2)、大野 真也1)、垣内 拓大3)、間瀬 一彦4、5)、奥沢 誠2)、田中正俊1)

18Aa-10	表面修飾Si(001)表面上の α -sexthiophene分子の構造と電子状態の解析	1)横国大工、2)東大物性研、3)横浜市国際総合	°豊島 弘明1)、井上 慧1)、向井 孝三2)、吉信 淳2)、大野真也1)、横山崇3)、田中正俊1)
18Aa-11	人工と天然のダイヤモンドの摩擦発光スペクトル	学習院大学理学部物理学科	今井悦子、三浦崇、荒川一郎

《休憩》

B会場 午前の部

口頭発表Ⅷ【薄膜Ⅱ】 9:00-12:00 座長:松倉祐輔(富士通研究所)/土佐正弘(NIMS)

18Ba-1	原子間力顕微鏡を用いた電界ドーピングによるNiO-ReRAMの導電性制御	1)鳥取大工、2)TEDREC	°依田 貴稔1)、木下 健太郎1)、2)、福原 貴博1)、岸田 悟1)、2)
18Ba-2	銅酸化物超伝導体単結晶をプローブとしたペロブスカイト型ReRAM抵抗スイッチングの解明	1)鳥取大学、2)TEDREC	°松原 勝彦1)、木下 健太郎1)、2)、花田 明紘1)、岸田 悟1)2)
18Ba-3	二元系遷移金属酸化物ReRAMにおけるReset過程のバルス応答	1)鳥取大学、2)鳥取大学電子ディスプレイ研究センター(TEDREC)	°森山 拓洋1)、木下 健太郎1)2)、依田 貴稔1)、福原 貴博1)、岸田 悟1)2)
18Ba-4	HfO ₂ -CBRAMのスイッチング特性	1)鳥取大学、2)TEDREC	°長谷川 祥1)、木下 健太郎1)2)、鶴田 茂之1)、岸田 悟1)2)
18Ba-5	マグネトロンスパッタ法による金属膜の膜厚分布(Ⅱ):ターゲットと基板の距離およびエロージョン分布の影響	1)富山大学理工学研究部	°木田 隆之1)、吉澤 寿夫1)、高安 勇吉1)、喜久田 寿郎1)、山崎 登志成1)

《休憩》

18Ba-6	高周波スパッタリングにおけるターゲット特性の酸化アルミニウム薄膜物性に与える影響	1)金沢工業大学・高度材料科学研究開発センター、2)株式会社フェローテックセラミックス	°土定 佑亮1)、坂本 宗明1)、佐藤 彰繁2)、岡本 研2)、荒堀 忠久2)、草野 英二1)
18Ba-7	高周波マグネトロンスパッタリング法によるCu ₂ ZnSnS ₄ 薄膜堆積において基板およびホットウォール温度が膜物性に与える影響	1)金沢工業大学	°市河 祐介1)、坂上 拓哉1)、國下 広樹1)、坂本 宗明1)、草野 英二1)
18Ba-8	磁場可変型対向スパッタによるニオブ薄膜作製	1)山口大学大学院	諸橋 信一1)、田中浩三1)、升元佑一1)、葛尾寛之1)、碓井圭太1)
18Ba-9	高真空スパッタ法で作製されたCo/バリア層付きたレンチへの超臨界CO ₂ 法によるCu埋め込み	1)東京理科大学 工学研究科 電気工学専攻、2)東京理科大学 工学部 工業化学科	°大野 泰典1)、伊藤 勝利1)、沼川 智則1)、上打田内 康太1)、大竹 勝人2)、齊藤 茂1)
18Ba-10	垂直磁気記録媒体用の擬似六方晶薄膜における六方晶原子層積層のコヒーレンシー — Ru代替材料の発見からCo基強磁性薄膜の結晶磁気異方性の向上まで—	東北大工	斎藤 伸

《休憩》

A会場 午後の部

口頭発表Ⅸ【表面科学Ⅱ】 13:00-15:30 座長:田中正俊(横浜国大)/藤田大介(NIMS)

18Ap-1	超高輝度・高スピン偏極低エネルギー電子顕微鏡を用いた表面研究	大阪電通大	安江常夫
18Ap-2	磁壁移動型メモリ材料 Co/Ni垂直磁化膜の磁区構造-超高輝度・高スピン偏極LEEMによる観察-	1)大阪電通大、2)アリゾナ州立大	鈴木 雅彦1)、安江 常夫1)、越川 孝範1)、Ernst Bauer2)
18Ap-3	イオン衝撃グラファイト表面の電子状態解析	1)横国院工、2)東大院総合文化	°牛山 翔太1)、青木 優2)、母袋 雄也2)、首藤 健一1)、増田 茂2)
18Ap-4	ベンゼンチオール吸着分子のコヒーレントフォノン分光	1)横国大院工 2)防大応物	°土井 幸司郎1) 首藤健一1) 片山郁文1) 武田 淳1) 北島正弘2)

《休憩》

18Ap-5	低温Ag(111)表面上における酸素分子の物理吸着構造と磁気状態	1)東大生研	°松本 益明1)、風間 吉則1)、杉本 敏樹1)、福谷 克之1)、岡野 達雄1)
18Ap-6	超熱酸素分子線によるCu(110)表面上での酸化生成の表面温度依存性	1)阪大リノベーション、2)阪大院理、3)原子力機構	°橋之口 道宏1)、岡田 美智雄1、2)、吉越 章隆3)、寺岡 有殿3)
18Ap-7	各種表面の酸素ラジカルの再結合係数測定	1)株式会社アルバック 筑波超材研、2)同半電研	°榎藤 麻衣子1)、石樽 文昭1)、稲吉 さかえ1)、小方 誠司2)
18Ap-8	ガラスキャピラリーを用いたアルゴンクラスターイオンビームの集束	1)兵庫県大院工、2)兵庫県大工	°正司 和夫1)、出水 元基2)、井内 健輔1)、盛谷 浩右1)、乾 徳夫1)、持地 広造1)

閉会式 15:30-

B会場 午後の部

口頭発表Ⅹ【薄膜Ⅲ・プラズマ科学技術】 13:00-15:30 座長:斎藤伸(東北大)/中野武雄(成蹊大)

18Bp-1	Mg薄膜の水素吸蔵過程の観察に向けた水素雰囲気中NRAの開発	1)筑波大数理、2)筑波大研究基盤総合センター、3)東大生研	°原田 俊也1)、成田 洋平1)、山崎 幸春2)、石井 聡2)、小倉 正平3)、米村 博樹3)、松本 益明3)、福谷 克之3)、関場 大一郎1)
18Bp-2	Mg薄膜の水素吸蔵過程における弾性応力依存性	1)筑波大数理、2)筑波大研究基盤総合センター、3)東大生研	°成田 洋平1)、原田 俊也1)、山崎 幸春2)、石井 聡2)、小倉 正平3)、米村 博樹3)、松本 益明3)、福谷 克之3)、関場 大一郎2)
18Bp-3	水素照射下で生じる、ステンレス鋼の表面応力	1)物・材機構、2)Indian Institute of Technology、3)東邦大理	板倉明子1) Saransh Shin1)2) 高木祥示3) 後藤哲二3)

《休憩》

18Bp-4	コンビナトリアルによるプラズマ科学の構築と有機材料の超微細加工への展開	名大工	堀 勝
18Bp-5	プラズマ電子アブレーションにおけるブルーミングの特性	1)東大工	伴野 達也1)
18Bp-6	パルスマイクロ放電を用いたプラスチック製マイクロ流路チップ内壁処理	鶴岡高専	吉木 宏之
18Bp-7	国際核融合材料照射施設(IFMIF)の液体リチウム試験ループ用真空排気系の製作と初期運転	1)原子力機構	°中村 和幸1)、井田 瑞穂1)、金村 卓司1)、近藤 浩夫1)、新妻 重人1)、平川 康1)、古川 智弘1)、渡辺 一慶1)、若井 栄一1)
18Bp-8	Arガスをを用いた容量結合型RFプラズマ中における金属の電流電圧特性Ⅶ	1)広国院大工	久保 隆1)

発表者へのご案内

1. 口頭発表

講演時間は15分（討論時間5分を含む）です。講演時に使用可能な機材は液晶プロジェクタ（接続コネクタ：mini D-Sub15pin）のみです（ノートパソコンは持参ください）。休憩時間やセッション開始前にファイルの動作確認をお願いいたします。PC不調等の対応については、各自の責任にてお願い致します。コンピュータ持参不可の場合や、機器故障、不調の場合を考慮して、各会場に発表用のパソコンを用意いたします。会場のパソコンを使用する場合は必ずPDF形式のファイルをご準備ください。USBメモリーでのデータ持参をお願いいたします。休憩時間やセッション開始前にファイルの動作確認をお願いいたします。

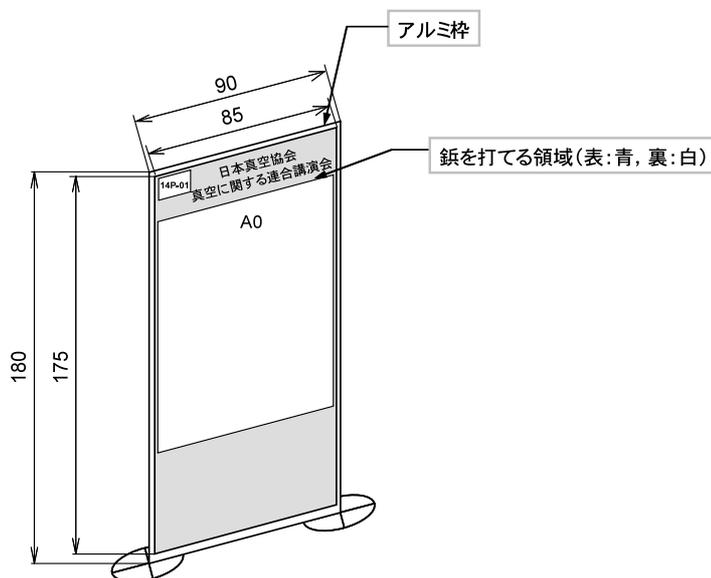
2. ポスター発表

ポスター展示時間は下の表の通りです。コアタイムではポスターの前で説明をお願いいたします。パネルの大きさは下図のように縦175cm×横85cmです。パネル左上に縦10cm×横20cmの余白をとってください。余白に事務局で発表番号を貼ります。ポスター貼り付けには押しピンのみ使用可能です。押しピンは会場にて用意いたします。

	11月16日（水）	11月17日（木）
展示開始	12:00	12:00
コアタイム（奇数）	14:00-15:00	13:00-14:00
コアタイム（偶数）	15:00-16:00	14:00-15:00
撤収開始	17:00	17:00

●ポスターボード概略図●

単位：cm



3. 優秀ポスター投票と発表

ポスターセッション開催中に参加票添付の投票用紙にて優秀ポスターの投票をお願いいたします。なお、日本真空協会研究部会選考委員にはこれとは別に所定の票が割り当てられます。優秀ポスター選考対象者は、ポスター番号の横に表示されています。投票箱はポスター会場入り口付近に設置します。投票締切りは11月16日（水）、17日（木）ともポスターセッション終了15分後です。結果の発表は17日（木）16:30頃に3F受付付近で行う予定です。また優秀ポスター発表の筆頭著者を懇親会に招待し、懇親会場（学習院輔仁会館2階さくら

ラウンジ) において表彰式を行います。皆様のご協力をお願いいたします。

会場案内図

J R山手線「目白駅」より徒歩1分です。大学構内及び周辺には利用できる駐車場がありませんので、自動車でのご来場は固くお断りいたします。

